

# 第十六届全国 LED 产业发展与技术 (2018'LED) 暨 2018 全国 LED 显示应用技术交流及产业发展研讨会 联合征文通知

各相关单位:

十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。LED 产业作为国家战略性新兴产业的重要组成部分和信息化和工业化融合发展的重要内容,一直把创新作为引领发展的第一动力,近年来 LED 新技术层出不穷,产业持续增长,在我国电子信息产业中起到了带动和引领的作用。随着 LED 产业逐步走向成熟,LED 相关企业也正在经历着技术、装备的再升级,市场竞争越来越激烈,企业间的并购、重组、合作将更有利于产业的升级,且企业的竞争力大大增强。

在此前提条件下,中国光学光电子行业协会光电器件分会、发光二极管显示应用分会将于今年 9—10 月在张家港联合举办“第十六届全国 LED 产业发展与技术 (2018'LED) 暨 2018 全国 LED 显示应用技术交流及产业发展研讨会”。

我们希望本届联合举办的研讨会能给大家带来更多的信息和机会。本届会议拟组织特邀报告、大会交流、产业论坛和产品、样品宣展等活动。热忱欢迎大陆和港澳台广大科技人员、工程技术人员和企业管理人员积极撰写论文,到会交流,开展产业研讨的平台,展示新产品、新技术、最新研究成果、技术进步和在应用、开发及生产实践中所取得的宝贵经验和成绩。

现将会议征文的有关事项通知如下:

## 一、征文范围:

1、LED 用衬底材料(蓝宝石、硅、SiC 及其它)技术和工艺研

究；

- 2、MO 源的技术研究；
- 3、LED 外延材料制备技术研究；
- 4、LED 芯片制造、器件封装技术研究；
- 5、半导体照明光源的相关技术研究；
- 6、高效、高稳定荧光粉技术研究；
- 7、LED 应用技术研究及市场前景分析；
- 8、与 LED 相关的光电器件技术研究；
- 9、LED 产业化中的技术及相关问题；
- 10、LED 测试技术和标准化、可靠性研究；
- 11、MOCVD 设备和 LED 生产相关设备研究及发展趋势；
- 12、海峡两岸 LED 产业合作发展的探讨与前景；
- 13、国际 LED 技术的发展动态及展望；
- 14、LED、半导体照明技术、工艺的最新进展以及发展前景等

综述类论文

- 15、LED 企业经营管理和资本运作等；
- 16、LED 显示应用行业、技术国内外发展；
- 17、LED 显示应用新技术、新产品研究及开发成果；
- 18、COB、mini-LED、micro-LED 显示前沿技术探讨
- 19、LED 显示应用产品制造装备、材料、器件；
- 20、LED 显示系统控制、视频处理、播放系统及应用
- 21、LED 显示产品质量、可靠性、检测、结构和工艺；
- 22、LED 显示行业规范、技术标准；
- 23、其他 LED/半导体照明、相关显示技术及产品论文。

**二、重要时间：**

截稿日期：2018 年 5 月 10 日

录用通知：2018 年 6 月

### 三、论文邮寄方式：

1、用电子邮件发送到以下邮箱（不需要邮寄打印稿）。

LED显示应用分会：hyxh@leds.org.cn

光电器件分会：13933157199@139.com

2、请在文后提供详细通信地址及联系电话，以方便联系。

### 四、其它：

1、征文未在国内任何杂志公开发表过。

2、会议届时将邀请国内外厂商举办展示、演示会，主办方将以优惠条件提供场所。

3、有关事宜可与中国光协光电器件分会秘书处或LED显示应用分会秘书处联系。

联系人：张璐

刘育青

电话：021-52703216，13601977028 0311-87091253

传真：021-52703216 0311-87091358

E-mail：hyxh@leds.org.cn

13933157199@139.com

### 附件一：稿件格式



二〇一八年二月

## 附件一：稿件格式

为便于编印会议论文集，文稿用 word 格式，以 E-mail 形式提交，2000 字左右。要求中英文标题、摘要、关键词、作者姓名（汉拼），排列顺序：标题、作者姓名、单位、摘要、关键词、正文、参考文献。同时提交作者通信地址、邮编、电话及传真。

### 一、论文结构要求

1、标题(20 个字以内)、关键词(5 个)，作者姓名(不超过 6 位)、单位地址(含省、市、邮编)、摘要(以上均要求中英文)。摘要部分要求客观反映论文的主要内容，具有独立性和自含性，文字不能与正文雷同，不少于 250~300 个字。技术文章摘要包括：目的、方法、结果和结论；综述文章摘要包括：对所述的研究或技术发展情况进行简要概述，该技术目前的发展水平、作者的评论及未来展望等，中、英文对照。

2、正文——字数不限(以 2000 字左右为佳)，语句通畅，结构清晰，文中所提及术语及名称等尽量为中文，所配图表(含标注)皆以中文表述，且图片(黑白色)清晰。曲线图应去掉没有坐标一侧的框线及底纹，物理量用符号表示，用“/”与量纲单位隔开，如： $V/V$ ； $t/ns$ ； $J/(\mu A \cdot cm^{-2})$ ，刻度线应在框内侧，只保留主要刻度线。

3、参考文献——按正文中出现的次序列于文后，如引用期刊文章格式为：[序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].刊名,年,卷(期):起止页码，文献类型标识为：专著[M]，论文集[C]，期刊[J]，学位论文[D]，报告[R]，标准[S]，专利[P]，工具书[K]。范例：

[1] JONES K S, PRUSSIN S, WEBER E R, et al. A systematic analysis of defects in ion-implanted silicon [J].Appl Phys A, 1988, 45(1):342-347.

[2] 白居易.低噪声频率合成[M].陕西：西安交通大学出版社，1995：50-70.

[3] WEN Z M, CHOO K F. The optimum thermal of microchannel heat sinks[C]//IEEE CPMT Electronic Packaging Technology Conf. New York, USA, 1997:123-129.

4、作者简介——提供最多三位作者的简介(在校生要给出导师简介)，格式如下：姓名(出生年—)，性别，(民族—汉族可省略)，籍贯，职称，学位，学历，简历及研究方向(任选)，E-mail 等，并在文后附第一作者近期一寸免冠证件照。